

关键指标

频率: 0.9~1.3GHz
 移相范围: 5.625~354.375°
 移相精度均方根: 1°
 插入损耗: 6dB
 工作电压: -5V
 控制电平: 0/+5V
 芯片尺寸: 3.77mm×1.37mm×0.1 mm

产品简介

HG162Y-1 是一款 0.9~1.3GHz 六位数控移相器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 插入损耗为 6dB, 移相精度均方根为 1°, 输入输出驻波比为 1.5/1.5。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}= -5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.9~1.3		
输入驻波	-	1.5	-
输出驻波	-	1.5	-
插入损耗(dB)	-	6	-
幅度波动(dB)	-	±0.8	-
移相精度(°)	-	-3~3	-
移相精度均方根(°)	-	1	-

真值表 (0: 0V, 1: +5V)

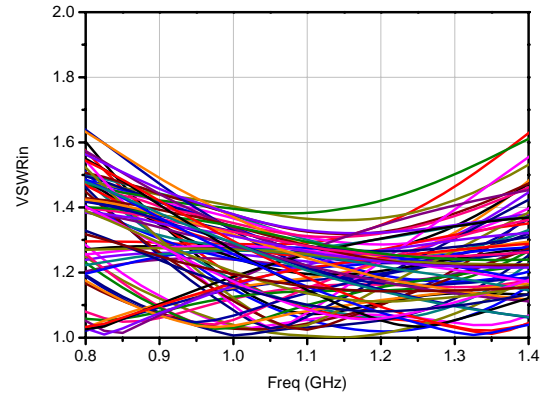
状态	C1	C2	C3	C4	C5	C6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

绝对额定最大值

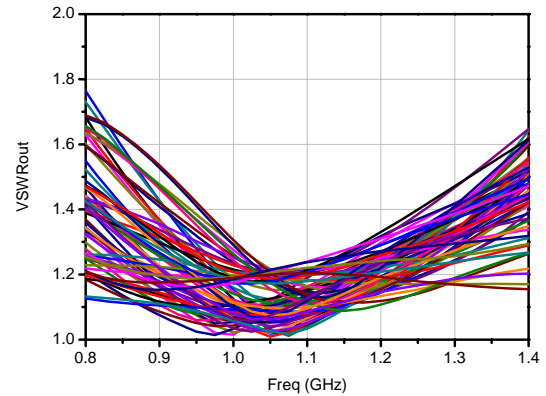
最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

典型测试曲线

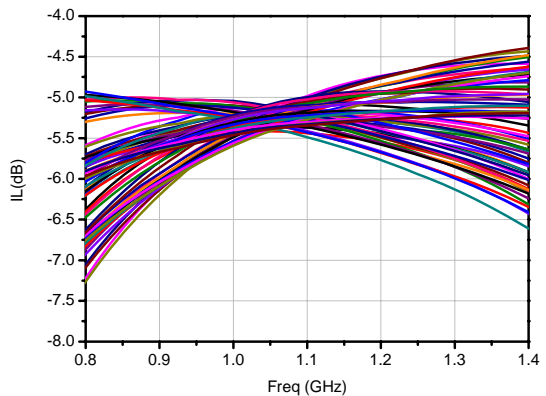
输入驻波



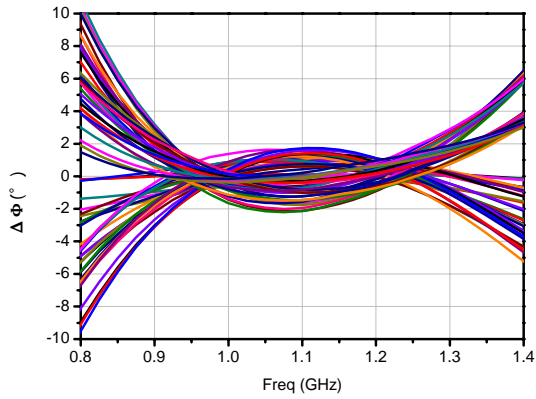
输出驻波



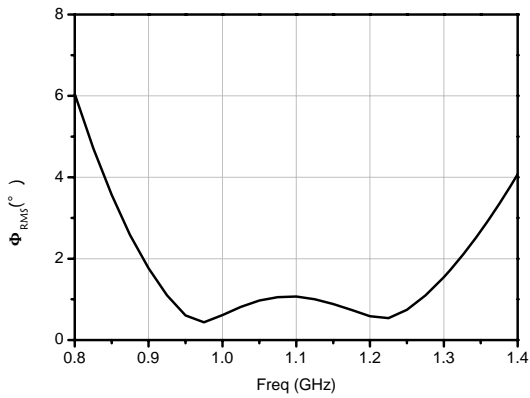
插入损耗



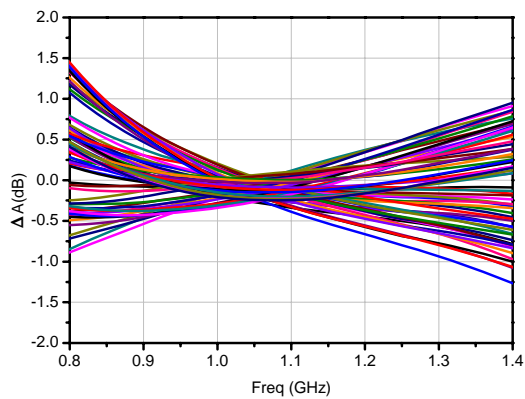
移相精度



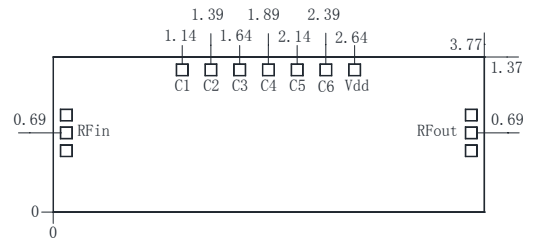
移相精度均方根



幅度波动



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。